

# 加圧・加熱なしの接合

Bonding without pressurizing nor heating



TOHOKU  
UNIVERSITY

## 原子拡散接合装置 BC7000

Atomic Diffusion Bonding Equipment BC7000

キヤノン アネルバ 株式会社

CANON ANELVA CORPORATION

Canon

CANON ANELVA CORP.

Atomic  
Diffusion  
Bonding

## スループット 1セット 210秒を実現

Realization of 210sec process per 1set

加熱不要

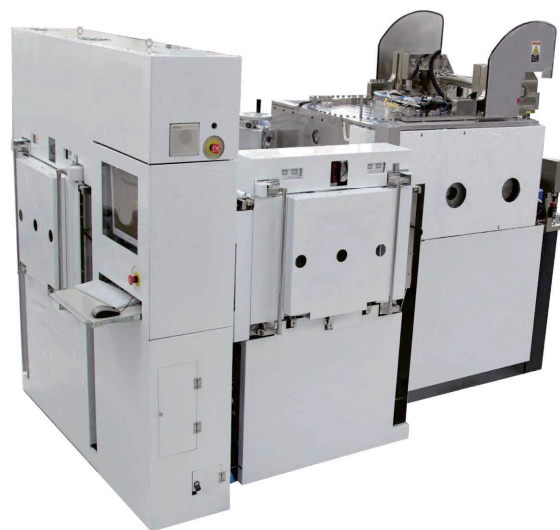
Without heating

加圧不要

Without pressurizing

異種材料

Hetero-bondings

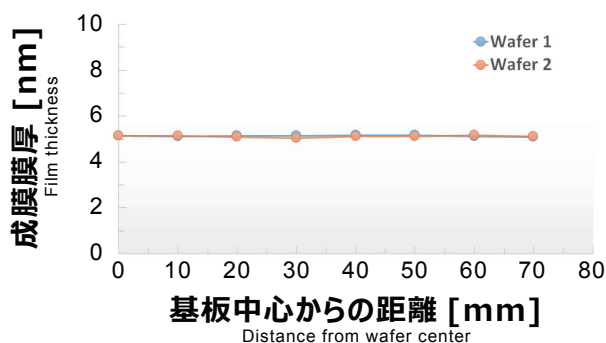


## φ6 インチスパッタリング特性

Sputtering characteristics of 6 inch wafer

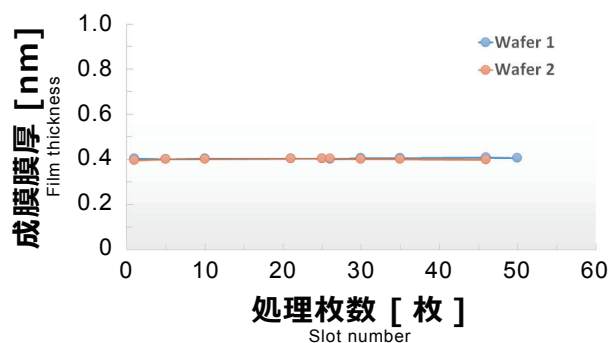
### 面内均一性

Film thickness uniformity within a wafer



### 基板間分布

Film thickness repeatability



## 開発ロードマップ

Development road map

2019

2020

2021

2022

基板サイズ

Substrate size

φ 100mm, φ 150mm

φ 200mm, φ 300mm

<0.15mm

アライメント精度

Alignment accuracy

<1.0 μm

<0.1 μm

# 表面荒さを改善する新スパッタ法

Surface roughness improvement technology  
by new sputtering method

## エネルギートリートメントスパッタリング

Energy Treatment Sputtering

キヤノン アネルバ 株式会社

CANON ANELVA CORPORATION



TOHOKU  
UNIVERSITY

Canon

CANON ANELVA CORP.

Atomic  
Diffusion  
Bonding

## 成膜による高平坦化

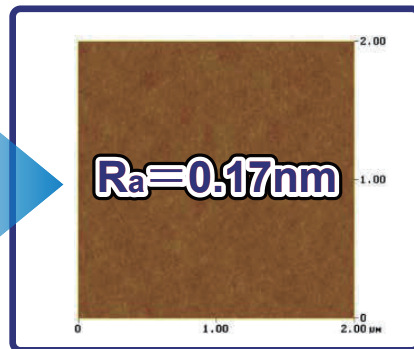
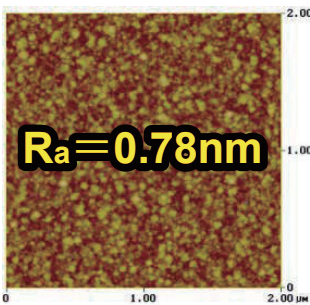
Fabrication of high smooth deposition film

従来スパッタ

Conventional sputtering

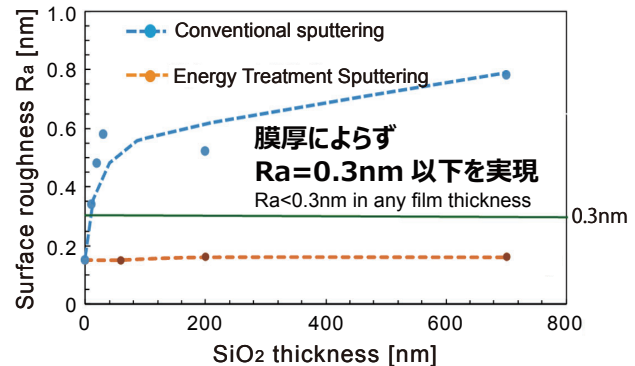
エネルギートリートメント  
スパッタリング

Energy Treatment Sputtering



## 従来スパッタとエネルギートリートメント スパッタリングの平坦性比較

Surface roughness comparison between conventional sputtering and energy treatment sputtering



## 成膜による荒れた表面の平坦化

Smoothing of rough surface by deposition

初期表面

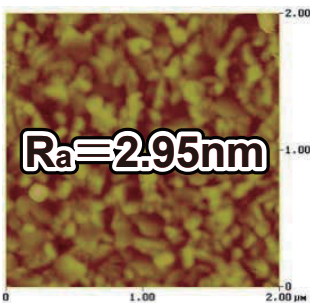
Initial surface

従来スパッタ

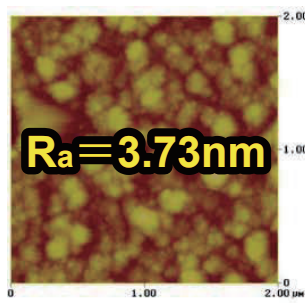
Conventional sputtering

エネルギートリートメント  
スパッタリング

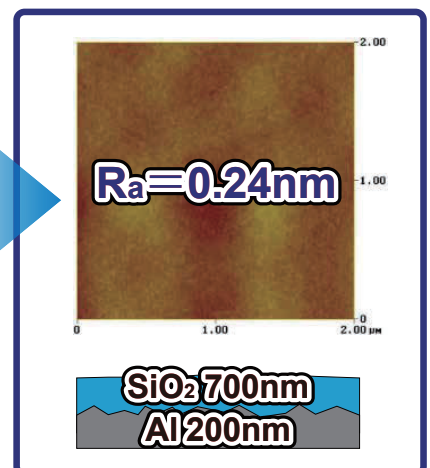
Energy Treatment Sputtering



Al 200nm



$\text{SiO}_2$  700nm  
Al 200nm



$\text{SiO}_2$  700nm  
Al 200nm